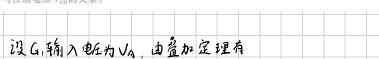
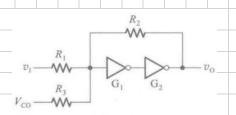
## 第十一周作业

[题 7.4] 图 P7.4 是用 CMOS 反相器接成的压控施密特触发电路,试分析它的转换电平  $V_{\tau_{\tau}}$ 、 $V_{\tau_{\tau}}$  以及回差电压  $\Delta V_{\tau}$  与控制电压  $V_{co}$ 的关系。

 $V_A = \sqrt{\frac{R_1 / R_3}{R_1 + R_2 / R_3}} + \sqrt{\frac{R_1 / R_2}{R_3 + R_1 / R_2}} + \sqrt{\frac{R_1 / R_3}{R_2 + R_2 / R_2}} + \sqrt{\frac{R_1 / R_3}{R_2 + R_2 / R_2}}$ 





① J<sub>1+</sub>

当VI增大时,Vo=0

VTH = VT+ R. +R211R3 + Vto R3+R,11R

# Va = VTH At, VI = VT+

 $V_{1+} = \left(V_{1+1} - V_{10} \frac{R_{1} | R_{2}|}{R_{1} + R_{1} | R_{2}|}\right) \frac{R_{1} + R_{2} | R_{2}|}{R_{2} | R_{3}|}$   $= V_{1+1} \left(1 + \frac{R_{1}}{R_{1}} + \frac{R_{2}}{R_{2}}\right) - \frac{R_{1}}{R_{2}} V_{10}$ 

2 V1-

与 Vit 推导过程相似,可得

 $V_{T-} = V_{TM} \left( 1 + \frac{R_i}{R_i} - \frac{R_i}{R_i} \right) - \frac{R_j}{R_j} V_{\ell o}$ 

3 DUT

 $D U_{1} = V_{7+} - V_{7-} = \left(V_{7H} \left(1 + \frac{R_{1}}{R_{2}} + \frac{R_{1}}{R_{2}}\right) - \frac{R_{1}}{R_{3}} V_{co}\right) - \left[V_{7H} \left(1 + \frac{R_{1}}{R_{3}} - \frac{R_{1}}{R_{2}}\right) - \frac{R_{2}}{R_{3}} V_{co}\right]$ 

= 2 R. VTH

- R. Viii) =) 印 DV t 与 Vco 无关

[题 7.9] 图 P7.9 是用 TTL 门电路接成的微分型单稳态电路,其中  $R_a$  阻值足够大,保证稳态时  $v_A$  为高电平。R 的阻值很小,保证稳态时  $v_{12}$  为低电平。试分析该电路在给定触发信号  $v_1$  作用下的工作过程,画出  $v_A$ 、 $v_{01}$ 、 $v_{12}$ 和  $v_0$  的电压波形。 $C_a$  的电容量很小,它与  $R_a$  组成微分电路。

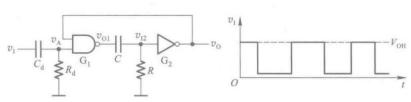


図 D7 0

